日本国特許庁 PATENT OFFICE

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 5月18日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第136599号

出 願 人 Applicant (s):

三菱マテリアル株式会社

2000年 6月23日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



特平11-136599

【書類名】 特許願

【整理番号】 98P01384

【提出日】 平成11年 5月18日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01J 11/00

【発明の名称】 FPD用保護膜及びその製造方法並びにこれを用いたF

· P D

【請求項の数】 20

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱マテリアル株式会

社 総合研究所内

【氏名】 桜井 英章

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱マテリアル株式会

社 総合研究所内

【氏名】 山下 行也

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱マテリアル株式会

社 総合研究所内

【氏名】 黒光 祥郎

【特許出願人】

【識別番号】 000006264

【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社

【代表者】 秋元 勇巳

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005315

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9721305

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 FPD用保護膜及びその製造方法並びにこれを用いた FPD 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板(13)の表面に形成されたCaO、SrO又はBaO膜(14a)と、該CaO、SrO又はBaO膜(14a)の表面に形成されたフッ化物層(14b)とからなることを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項2】基板(13)の表面に形成されたCaO、SrO又はBaO膜(34a)が、フッ化物層にて被覆されたCaO、SrO又はBaO粉末を用いて形成されたことを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項3】基板(13)の表面に形成されたアルカリ土類複合酸化物膜と、 該アルカリ土類複合酸化物膜の表面に形成されたフッ化物層とからなることを特 徴とするFPD用保護膜。

【請求項4】基板(13)の表面に形成されたアルカリ土類複合酸化物膜が、フッ化物層にて被覆されたアルカリ土類複合酸化物粉末を用いて形成されたことを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項5】基板(13)の表面に形成された希土類酸化物膜と、該希土類酸化物膜の表面に形成されたフッ化物層とからなることを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項6】基板(13)の表面に形成された希土類酸化物膜が、フッ化物層にて被覆された希土類酸化物粉末を用いて形成されたことを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項7】基板(13)の表面に形成されたアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜と、該アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面に形成されたフッ化物層とからなることを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項8】基板(13)の表面に形成されたアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜が、フッ化物層にて被覆されたアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を用いて形成されたことを特徴とするFPD用保護膜。

【請求項9】フッ化物層が、MOxFy(但し、0≦x<2、0<y≦4:M

は、Ca、Sr、Ba、アルカリ土類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類 金属と希土類金属との複合金属)であることを特徴とする請求項1ないし8記載 のFPD用保護膜。

【請求項10】フッ化物層が、ガス状フッ素化剤とCaO、SrO、BaO又はアルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物との反応によって得られたことを特徴とする請求項1ないし9記載のFPD用保護膜。

【請求項11】ガス状フッ素化剤が、フッ素ガス、フッ化水素ガス、BF $_3$ 、SbF $_5$ 又はSF $_4$ のいずれかであることを特徴とする請求項10記載のFPD用保護膜。

【請求項12】フッ化物層の厚さが、0.1~1000nmであることを特徴とする請求項1ないし11のいずれかに記載のFPD用保護膜。

【請求項13】基板(13)の表面に、CaO、SrO、BaO又はアルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(14a)を形成する工程と、該CaO、SrO、BaO又はアルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(14a)をガス状フッ素化剤にて表面処理することにより、前記該CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物膜、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(14a)の表面にフッ化物層(14b)を形成する工程とを含むことを特徴とするFPD用保護膜の製造方法。

【請求項14】CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をガス状フッ素化剤にて表面処理することにより、前記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をフッ化物層にて被覆する工程と、前記フッ化物層により被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末とバインダと溶媒とを混合してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカ

リ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物ペースト、或いはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物分散液を調整する工程と、前記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物ペースト、或いはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物と希土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物分散液を用いて基板の表面にCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(34a)を形成する工程とを含むことを特徴とするFPD用保護膜の製造方法

【請求項15】圧力が、1~760Torrのガス状フッ素化剤によりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜又はCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を表面処理したことを特徴とする請求項13又は14記載のFPD用保護膜の製造方法。

【請求項16】ガス状フッ素化剤が、フッ素ガス、フッ化水素ガス、BF $_3$ 、 S b F_5 又はSF $_4$ のいずれかであることを特徴とする請求項13ないし15のいずれかに記載のFPD用保護膜の製造方法。

【請求項17】請求項2、4、6又は8記載のFPD用保護膜を形成するためにフッ化物膜にて被覆されたことを特徴とするCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の粉末。

【請求項18】請求項17記載のフッ化物層にて被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末とバインダと溶媒とを混合して調整されたことを特徴とするCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜形成用CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と

希土類酸化物との複合酸化物のペースト。

【請求項19】請求項17記載のフッ化物層にて被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末とバインダと溶媒とを混合して調整されたことを特徴とするCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜形成用CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の分散液。

【請求項20】請求項1ないし12のいずれかに記載の保護膜を用いたことを 特徴とするFPD。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、PDP(plasma display panel:プラズマディスプレイパネル)、PALC(plasma addressed liquidcrystal display)等のFPD(flatpaneldisplay)用保護膜及びその製造方法並びにこれを用いたFPDに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来より、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法やイオンプレーティング法などの真空プロセスを用いてFPDの保護膜を形成する方法と比較し、低コストで量産性に優れた保護膜の形成方法として、MgO粉末、Mg(OH)2粉末及びMgO粉末とMg(OH)2の混合粉末、或いは希土類酸化物粉末を含有したペースト又はコーティング液を用い、スクリーン印刷法、スピンコート法、スプレーコート法などの湿式プロセスにより形成する方法が提案されている(例えば、特開平3-67437号、特開平7-220640号、特開平7-147136号、特開平7-335134号、特開平8-111177号、特開平8-111

167381号、特開平8-261425号、特開平9-12940号、特開平 9-12976号、特開平8-96718号など)。

また、この種の保護膜として、背面ガラス基板上に放電維持電極対と誘電体層と保護層とが積層され、前面ガラス基板の裏面に蛍光体層が形成され、両基板間に放電により紫外線を発生する不活性ガスが封止され、更に保護層が二次電子放出材料のフッ素化MgOにより形成されたプラズマディスプレイパネル用の二次電子放出材料が開示されている(特開平7-201280号)。この二次電子放出材料では、保護層はMgOを構成する酸素の一部をフッ素で置換する、即ちMgOイオン結晶を形成する格子の酸素原子位置の一部をフッ素原子で置換することにより、MgO $_{1-x}$ F $_{y}$ (但し、0<x<1、0<y<y<1)の一般式で表わされるフッ素化MgOにて構成される。

このプラズマディスプレイパネル用の二次電子放出材料では、保護層としてM $gO_{1-x}F_y$ で表わされるフッ素化MgOを用いたので、原子価制御により局在準位が得られ、放電開始電圧を下げることができる。この結果、高精細のパネル形成が可能となり、経時的にも安定な保護膜が得られるようになっている。

[0003]

【発明が解決しょうとする課題】

しかし、上記従来の各公報に記載された保護膜の形成方法では、MgO粉末、Mg(OH)₂粉末、あるいはMgOとMg(OH)₂の混合粉末を焼成して得られたMgO粉末や希土類酸化物粉末が微粒子であるため、表面積が大きく、この表面は大気中の炭酸ガスと比較的容易に反応して炭酸塩に変化するおそれがあった。このためFPDの放電中に炭酸ガスが放電空間中に放出され、放電特性が低下する問題点があった。

また、上記従来の特開平 7 - 2 0 1 2 8 0 号公報に示されたプラズマディスプレイパネル用の二次電子放出材料では、保護層全体がMgO_{1-x}F_yで表わされるフッ素化MgOにより構成され、この保護層と基板(誘電体層)との熱膨張係数の差が比較的大きいため、保護層としてMgO膜を用いた場合より保護層と基板(誘電体層)との密着性及び整合性が低下し、かつ電気絶縁性が劣る問題点があった。

本発明の第1の目的は、基板(誘電体層)との密着性及び整合性の低下を防止でき、かつ電気絶縁性の低下を防止できる、FPD用保護膜及びその製造方法を提供することにある。

本発明の第2の目的は、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物が大気中のCO2ガスと反応するのをフッ化物層が阻止することにより、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物がFPDに有害なCa、Sr、Ba、アルカリ土類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希土類金属の複合金属の炭酸塩に変質するのを防止できる、即ちCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物の複合酸化物膜の耐環境性を向上できる、FPD用保護膜及びその製造方法を提供することにある。

本発明の第3の目的は、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、 希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物の複合酸化物膜の表面、 或いはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又は アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜を形成するCaO、SrO 、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と 希土類酸化物の複合酸化物粉末の表面に、二次電子放出能の高いフッ化物層を比 較的容易に形成できる、FPD用保護膜及びその製造方法を提供することにある

本発明の第4の目的は、製造工程を大幅に低減・短縮できる、保護膜を用いた FPDを提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】

請求項1に係わる発明は、図1に示す様に、基板13の表面に形成されたCaO、SrO又はBaO膜14aとCaO、SrO又はBaO膜14aの表面に形成されたフッ化層14bとを備えたFPD用保護膜である。

この請求項1に記載されたFPD用膜では、CaO、SrO又はBaO膜14aの表面がフッ化物層14bにより被覆されるため、FPD10(図2参照)の製造過程において保護膜14が大気中に長時間曝されても、CaO、SrO又はBaO膜14a中のCaO、SrO又はBaOが大気中のCO2がスと殆ど反応しない。この結果、CaO、SrO又はBaO14a中のCaO、SrO又はBaOがFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩SrCO3、CaCO3又はBaCO3に変質することが殆どない。

また、基板13には保護膜14のうち基板13と熱膨張係数が略同一のCaO、SrO又はBaO膜14aが接着されるので、熱サイクルにより保護膜14が基板13から剥離せず、保護膜14の基板13に対する密着性および整合性が極めて良好となる。

[0005]

請求項2に係わる発明は、図3に示す様に、基板13の表面に形成されるCaO、SrO又はBaO膜34aがフッ化物層にて被覆されたCaO、SrO又はBaO粉末を用いて形成されたFPD用保護膜である。

この請求項2に記載されたFPD用保護膜では、CaO、SrO又はBaO粉末の表面がフッ化物層により被覆されるため、FPD10(図4参照)の製造過程において保護膜34が大気中に長時間曝されても、CaO、SrO又はBaO膜34a中のCaO、SrO又はBaOが大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、CaO、SrO又はBaO膜34a中のCaO、SrO又はBaOがFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩SrCO3、CaCO3又はBaOがFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩SrCO3、CaCO3又はBaO粉末の機械的特性は表面にフッ化物層のないSrO、CaO又はBaO粉末の機械的特性は表面にフッ化物層のないSrO、CaO又はBaO粉末と略同一であり、より好ましい。

[0006]

請求項3に係わる発明は、図1に示す様に、基板13の表面に形成されたアルカリ土類複合酸化物膜14aとアルカリ土類複合酸化物膜14aの表面に形成されたフッ化層14bとを備えたFPD用保護膜である。

この請求項3に記載されたFPD用膜では、アルカリ土類複合酸化物膜14a

の表面がフッ化物層14 b により被覆されるため、FPD10(図2参照)の製造過程において保護膜14が大気中に長時間曝されても、アルカリ土類複合酸化物膜14 a 中のアルカリ土類複合酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、アルカリ土類複合酸化物14 a 中のアルカリ土類複合酸化物がFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することが殆どない。ここにアルカリ土類複合酸化物としては、例えば、(Ca・Sr)〇、(Mg・Sr)〇又は(Sr・Ba)〇が挙げられる。

また、基板13には保護膜14のうち基板13と熱膨張係数が略同一のアルカリ土類複合酸化物膜14aが接着されるので、熱サイクルにより保護膜14が基板13から剥離せず、保護膜14の基板13に対する密着性および整合性が極めて良好となる。

[0007]

請求項4に係わる発明は、図3に示す様に、基板13の表面に形成されるアルカリ土類複合酸化物膜34aがフッ化物層にて被覆されたアルカリ土類複合酸化物粉末を用いて形成されたFPD用保護膜である。

この請求項4に記載されたFPD用保護膜では、アルカリ土類複合酸化物粉末の表面がフッ化物層により被覆されるため、FPD10(図4参照)の製造過程において保護膜34が大気中に長時間曝されても、アルカリ土類複合酸化物膜34a中のアルカリ土類複合酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、アルカリ土類複合酸化物膜34a中のアルカリ土類複合酸化物がFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することが殆どない。また、アルカリ土類複合酸化物粉末の機械的特性は表面にフッ化物層のないアルカリ土類複合酸化物粉末と略同一であり、より好ましい。ここにアルカリ土類複合酸化物粉末と略同一であり、より好ましい。ここにアルカリ土類複合酸化物としては、例えば、(Ca・Sr)O、(Mg・Sr)O又は(Sr・Ba)Oが挙げられる。

[0008]

請求項5に係わる発明は、図1に示す様に、基板13の表面に形成された希土類酸化物膜14aと希土類酸化物膜14aの表面に形成されたフッ化層14bとを備えたFPD用保護膜である。

この請求項5に記載されたFPD用膜では、希土類酸化物膜14aの表面がフッ化物層14bにより被覆されるため、FPD10(図2参照)の製造過程において保護膜14が大気中に長時間曝されても、希土類酸化物膜14a中の希土類酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、希土類酸化物膜14a中の希土類酸化物がFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することが殆どない。

[0009]

請求項6に係わる発明は、図3に示す様に、基板13の表面に形成される希土 類酸化物膜34aがフッ化物層にて被覆された希土類酸化物粉末を用いて形成されたFPD用保護膜である。

[0010]

請求項7に係わる発明は、図1に示す様に、基板13の表面に形成されたアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aとアルカリ土類酸化物と

希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面に形成されたフッ化層14bとを備えたFPD用保護膜である。

この請求項7に記載されたFPD用膜では、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面がフッ化物層14bにより被覆されるため、FPD10(図2参照)の製造過程において保護膜14が大気中に長時間曝されても、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14a中のアルカリ土類酸化物と希土類酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物がFPD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することが殆どない。

[0011]

請求項8に係わる発明は、図3に示す様に、基板13の表面に形成されるアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34aがフッ化物層にて被覆されたアルカリ土類酸化物と希土類酸化物粉末を用いて形成されたFPD用保護膜である。

この請求項8に記載されたFPD用保護膜では、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物粉末の表面がフッ化物層により被覆されるため、FPD10(図4参照)の製造過程において保護膜34が大気中に長時間曝されても、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34a中のアルカリ土類酸化物と希土類酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物がF土類酸化物との複合酸化物膜34a中のアルカリ土類酸化物と希土類酸化物がF

PD10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することが殆どない。また、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との粉末の機械的特性は表面にフッ化物層のないアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との粉末と略同一であり、より好ましい。ここに複合酸化物としては、例えば、MRe $_2$ O $_4$ (M=Mg、Ca、Sr又はBa等のアルカリ土類金属;Re=Gd、Y、又はLa等の希土類金属)、また、例えば、アルカリ土類酸化物に、数モル%程度希土類化合物を添加したものでもよい。MO:ReO(具体例、MgO:La $_2$ O $_3$, MgO:Sc $_2$ O $_3$, MgO:Y $_2$ O $_3$ 等)

[0012]

請求項9から12に係わる発明は、フッ化物層は、 $MOxFy(0 \le x < 2, 0 < y \le 4:M$ は、CaxSrxBax、Punny1 土類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希土類金属との複合金属)であることが好ましく、フッ化物層をガス状フッ素化剤とCaOxSrOxBaOx アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物との反応によって得ることが好ましい。更に、ガス状フッ素化剤としてフッ素ガス、フッ化水素ガス、 BF_3 、 SbF_5 又は SF_4 のいずれか、特にフッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましく、フッ化物層の厚さをOxDx1 CxDx2 CxDx3 CxDx4 CxDx5 CxDx6 CxDx6 CxDx7 CxDx8 CxDx9 CxDx9

[0013]

請求項13に係わる発明は、図1に示す様に、基板13の表面にCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aを形成する工程と、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aをガス状フッ素化剤にて表面処理することによりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面にフッ化物層14bを形成する工程とを含むFPDの保護膜の製造方法である。

[0014]

請求項14に係わる発明は、図3に示す様に、CaO、SrO、BaO、アル

カリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をガス状フッ素化剤にて表面処理することによりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をフッ化物層にて被覆する工程と、フッ化物層により被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末とバインダと溶媒とを混合したCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複合酸化物、不工類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、系土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、不工類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物以34aを形成する工程とを含むFPD用保護膜の製造方法である。

[0015]

この13または14に記載されたFPD用保護膜の製造方法では、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物膜14a又は34a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物がFPD10の機能にとって有害な炭酸塩に殆ど変質しないため、後工程で上記炭酸塩を除去する脱ガス処理工程時間を短縮又は脱ガス処理工程を省くことができ、FPD10の製造コストを低減できる。

[0016]

また、請求項15または16のFPD用保護膜の製造方法において、圧力が1~760Torrのガス状フッ素化剤によりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜あるいはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を表面処理

することが好ましく、ガス状フッ素化剤としてフッ素ガス、フッ化水素ガス、B F_3 、 SbF_5 又は SF_4 のいずれか、特にフッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましい。

[0017]

請求項17に係わる発明は、請求項2、4、6のいずれか記載のFPD用保護膜を形成するフッ化物層に被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の粉末である。

[0018]

請求項18に係わる発明は、請求項14ないし16記載のFPD用保護膜の製造方法で使用されるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物のペーストである。

[0019]

請求項19に係わる発明は、請求項14ないし16記載のFPD用保護膜の製造方法で使用されるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の分散液である

[0020]

請求項20に係わる発明は、請求項1ないし12のいずれかに記載の保護膜を 用いたことを特徴とするFPDである。この請求項20に記載されたFPDでは 、FPDの製造工程を大幅に低減・短縮できるので、安価にFPDを製造できる

[0021]

【発明の実施の形態】

次に、本発明の第1の実施の形態を図面に基づいて説明する。

本発明のFPDとしてPDP、PALC等が挙げられる。この実施の形態では 、PDPについて説明する。

図1及び図2に示す様に、AC型のPDP10は背面ガラス基板11上に所定

の間隔をあけて形成された隔壁12を介して前面ガラス基板13を被覆せることにより構成される。前面ガラス基板13の両面のうち背面ガラス基板11に対向する面には表示電極16及び透明誘電体層17を介してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aが形成され、このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面にはフッ化物層14bが形成される。背面ガラス基板11上には放電セル18内に位置し、かつ上記表示電極16に対向するようにアドレス電極19が形成される。また放電セル18内には隔壁12の側面から背面ガラス基板11の上面にかけて蛍光体層21が形成される。更に放電セル18内には放電ガス(図示せず)が注入される。

[0022]

上記フッ化物層14bは、MOxFy (0≤x<2, 0<y≤4:Mは、Ca 、Sr、Ba、アルカリ土類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希 土類金属との複合金属)であり、例えば、 MF_2 層、 $MO_{0.5}F$ 層、 $MO_{0.25}F_1$ ₅層、MF₄層、MOF₂層、MF₃層、MOF層、MF_{2,66}層、又はMOF_{0,66}層 等である。また、フッ化物層14bはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複 合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化 物膜14aを形成するCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土 類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物とガス状フッ 素化剤との反応によって得ることができ、ガス状フッ素化剤としては反応性の高 さや汎用性の観点からフッ素ガス、フッ化水素ガス、 BF_3 、 SbF_5 又は SF_4 のいずれか、特にフッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましい。また フッ化物層14bの厚さはCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物 、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物のCO 2ガスとの反応阻止向上と、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物 、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物及びガ ス状フッ素化剤の反応時間とのバランスにより決定され、好ましくは0.1~1 000nmの範囲内、更に好ましくは0.1~100nmの範囲内に形成される

。フッ化物層14bの厚さを0.1~1000nmの範囲内に限定したのは、1000nmを越えるとCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物及びガス状フッ素化剤の反応時間が長くなって作業性が悪くなるためである。

[0023]

このように構成されたPDPの保護膜の製造方法を説明する。

[1] 蒸着法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

先ず、図1に示すように、前面ガラス基板13の表面に表示電極16となるAgやAu等の電極用ペーストをスクリーン印刷法により所定の間隔をあけて塗布し乾燥・焼成した後に、上記前面ガラス基板13の表面に透明誘電体層17となる透明ガラスペーストをスクリーン印刷法により前面ガラス基板13の表面全体に塗布し乾燥する。上記前面ガラス基板13を大気中で100~200℃に10~60分間保持して乾燥した後に、大気中で500~600℃に10~60分間保持して焼成する。

次に、純度99.5%以上のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物焼結体ペレットを電子ビーム蒸着法等の蒸着法により上記ガラス基板13の透明誘電体層17表面を覆うように蒸着してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、第14を形成する。このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、不土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14の成膜条件は、加速電圧が5~30kV、蒸着圧力が0.1×10⁻²~10×10⁻² Pa、蒸着距離が100~1000mmの範囲内にあることが好ましい。更にこの前面ガラス基板13をガス状フッ素化剤雰囲気中(温度5~100℃)に0.1~120分間保持してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、充土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面を改質し、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、充土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aの表面にフ

ッ化物層 14b を形成する。上記ガス状フッ素化剤としては、フッ素ガス、フッ化水素ガス、BF $_3$ 、SbF $_5$ 又はSF $_4$ のいずれか、特にフッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましく、このガス状フッ素化剤の圧力は好ましくは 16 ~16 OTorr、更に好ましくは 16 ~16 OTorr、更に好ましくは 16 ~16 OTorr、更に好ましくは 16 ~16 OTorrの範囲内に設定される。ガス状フッ素化剤の圧力を 16 个16 OTorrの範囲内に限定したのは反応進行度、即ちフッ化物層の厚さの制御を容易にするためである。

[0024]

[2]スパッタリング法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

先ず上記 [1] と同様に電極付ガラス基板を作製した後、純度99.5%以上の5インチサイズのCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物ターゲットを用いてスパッタリング法によりガラス基板に透明誘電体層表面を覆うようにCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜を形成する。このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の成膜条件は、高周波出力が1kW、スパッタ圧力が0.50~3.0Pa、アルゴンガスに対する酸素濃度が5~50%、基板温度が20~300℃の範囲内であることが好ましい。

次に、上記[1]と同様にガス状フッ素化剤雰囲気中に保持してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面を改質し、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面にフッ化物層を形成する。

[0025]

[3] スクリーン印刷法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

予め気相法や液中合成法等により平均粒経が50~2000ÅのCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を作製しておく。先ず前面ガラス基板の表面に表示電極となるAgやAu等の電極用ペーストをスクリーン印刷法により所定の間隔をあけて塗布し乾燥・焼成した後に、上記前面ガラス基板の表面に透明誘電体相となる透明ガラスペーストをスクリーン印刷法により前面ガス基板の表面全体に塗布し乾燥する。次いでCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複合酸化物、系土類酸化物と発土類酸化物との複合酸化物、系土類酸化物と発土類酸化物との複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶媒を所定の割合で混合してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物ペーストをスクリーン印刷法により上記透明誘電体層の表面全体に塗布し乾燥する。

上記バインダとしては、アルカリ土類金属や希土類金属のアルコキシド、有機酸化合物、アセチルアセトネート(例えば、有機酸カルシウム、カルシウムアルコキシド、カルシウムアセチルアセトネート)や、エチルセルロース、エチルシリケート等が用いられ、溶媒としてはαーテルピネオール、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールアセテート、テレピン油等が用いられる。また上記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶媒の混合割合はO~10重量%、10~100重量%、及びO~30重量%に設定されることが好ましい。

次に上記前面ガラス基板を大気中で100~200℃に10~60分間保持して乾燥した後に、大気中で500~600℃に10~60分間保持して焼成する。更に上記[1]と同様に前記ガラス基板をガス状フッ素化剤雰囲気中に保持してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面を改質し、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、発土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面にフッ化物層を形成する。

[0026]

[4]スピンコート法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

上記「3〕と同様に、前面ガラス基板の表面に電極用ペースト及び誘電体層用 ペーストを塗布し乾燥・焼成した後に、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類 複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸 化物膜となるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物 、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶 媒を所定の割合で混合してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、 希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物分散液を 調製し、この分散液をスピンコート法により上記透明誘電体層の表面全体に成膜 し乾燥する。上記バインダとしては、アルカリ土類金属や希土類金属のアルコキ シド、有機酸化合物、アセチルアセネート(例えば、カルシウムアルコキシド、 有機酸カルシウム、カルシウムアセチルアセトネート)や、エチルシリケート等 が用いられ、溶媒としては、アルコール、セロソルブ等が用いられる。また上記 CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカ リ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶媒の混合割合 は0~40重量%、0.1~10重量%及び55~99.9重量%に設定される ことが好ましい。この前面ガラス基板を大気中で40~100℃に5~60分間 保持して乾燥した後に大気中で500~600℃に10~60分間保持して焼成 し、更に上記「1]と同様にガス状フッ素化剤雰囲気中に保持してCaO、Sr 〇、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物 と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面を改質しCaO、SrO、BaO、アル カリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物と の複合酸化物膜の表面にフッ化物層を形成する。

[0027]

このように製造されたPDPの保護膜では、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との

複合酸化物膜14aの表面がフッ化物層14bにより被覆されるため、PDP10の製造過程において保護膜14が大気中に長時間曝されても、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、不はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない。この結果、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物との複合酸化物膜14a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、不上類酸化物との複合酸化物膜14a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複合酸化物、不上類酸化物との複合酸化物にフはアルカリ土類酸化物との複合酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複合酸化物がPDP10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することは殆どないので、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、不上類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物に発出を消費的できる。

[0028]

また、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物が炭酸塩に殆ど変質しないため、後工程で上記炭酸塩を除去する脱ガス処理工程時間を短縮又は脱ガス処理工程を省くことができ、PDP10の製造コストを低減できる。

[0029]

更に透明誘電体層17には、保護膜14のうち誘電体層17と熱膨張係数が略同一のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜14aが接着されるので、熱サイクルにより保護膜14が透明誘電体層17から剥離せず、保護膜14の誘電体層17にたいする密着性及び整合性が極めて良好となる。

[0030]

図3及び図4は、本発明の第2の実施の形態を示す。 (図3及び図4において

図1及び図2と同一符号は同一部品を示す。)

この実施の形態では、前面ガラス基板13の表面に表示電極16及び透明誘電 体層17を介して保護膜34であるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合 酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物 膜34 aが形成される。このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物 、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34 aがフッ化物層にて被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化 物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末 を用いて形成される。上記フッ化物層は第1の実施の形態のフッ化物層と同様に 、MOxFy ($0 \le x < 2$, $0 < y \le 4$:Mは、Ca、Sr、Ba、Tルカリ土 類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希土類金属との複合金属)で あり、例えば、MF₂層、MO_{0.5}F層、MO_{0.25}F_{1.5}層、MF₄層、MOF₂層 , MF_3 層、 MOF 層, $\mathrm{MF}_{2.66}$ 層又は $\mathrm{MOF}_{0.66}$ 層等である。またフッ化物層 はCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアル カリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物とガス状フッ素化剤との反応によ って得ることができ、ガス状フッ素化剤としては反応性の高さや汎用性の観点か らフッ素ガス、フッ化水素ガス、BF $_3$ 、SbF $_5$ 又はSF $_4$ のいずれか、特にフ ッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましい。またフッ化物層の厚さは CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカ リ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物のCO₂ガスとの反応阻止向上と、 CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカ リ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物及びガス状フッ素化剤の反応時間と のバランスにより決定され、好ましくは0.1~1000nmの範囲内、更に好 ましくは0.1~100nmの範囲内に形成される。フッ化物層の厚さを0.1 ~1000nmの範囲内に限定したのは、1000nmを越えるとCaO、Sr O、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物 と希土類酸化物との複合酸化物及びガス状フッ素化剤の反応時間が長くなって作 業性が悪くなるためである。上記以外は第1の実施の形態と同一に構成される。

[0031]

この様に構成されたPDPの保護膜の製造方法を説明する。

[1] スクリーン印刷法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

先ず気相法又は液中合成法等により平均粒径が $50\sim2000$ AのCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を作製する。次いでこのをガス状フッ素化剤雰囲気中(温度 $5\sim100$ C)に $0.1\sim10$ 分間保持してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面を改質し、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面にフッ化物層を形成する。上記ガス状フッ素化剤としてはフッ素ガス、フッ化水素ガス、BF $_3$ 、SbF $_5$ 又はSF $_4$ のいずれか、特にフッ素ガス又はフッ化水素ガスを用いることが好ましく、このガス状フッ素化剤の圧力は好ましくは $1\sim760$ Torr、更に好ましくは $10\sim300$ Torrの範囲内に設定される。ガス状フッ素化剤の圧力を $1\sim760$ Torrの範囲内に限定したのは反応進行度、即ちフッ化物層の厚さの制御を容易にするためである

次に、図3に示すように、前面ガラス基板13の表面に表示電極16となるAgやAu等の電極用ペーストをスクリーン印刷法により所定の間隔をあけて塗布し乾燥・焼成した後に、上記前面ガラス基板13の表面に透明誘電体層17となる透明ガラスペーストをスクリーン印刷法により前面ガラス基板13の表面全体に塗布し乾燥する。またCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34aとなるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、系土類酸化物と発土類酸化物を発土類酸化物、系土類酸化物と発土類酸化物を発土類酸化物、系土類酸化物、スはアルカリ土類酸化物との複合酸化物粉末(上記表面がフッ化物層により被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、アはアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末)、バインダ及び溶媒を所定の割合で混合してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化

物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物ペーストをスクリーン印刷法により上記透明誘電体層 1 7 の表面全体に塗布し乾燥する。上記バインダとしては、アルカリ土類金属や希土類金属のアルコキシド、有機酸化合物、アセチルアセネート(例えば、有機酸カルシウム、カルシウムアルコキシド、カルシウムアセチルアセトネート)や、エチルセルロース、エチルシリケート等が用いられ、溶媒としては、αーテルピネオール、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールアセテート、テレピン油等が用いられる。

また上記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、 又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶媒 の混合割合は0.1~10重量%、10~99.9重量%及び0~30重量%に 設定されることが好ましい。更に上記前面ガラス基板13を大気中で100~2 00℃に10~60分間保持して乾燥した後に、大気中で500~600℃に1 0~60分間保持して焼成する。

[0032]

[2] スピンコート法によるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の形成。

先ず上記[1]と同様にしてCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面をフッ化物層により被覆する。次に前面ガラス基板の表面に電極用ペースト及び誘電体層用ペーストを塗布し乾燥・焼成した後に、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜となるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末(上記表面がフッ化物層により被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、不土類酸化物、スはアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末)、バインダ及び溶媒を所定の割合で混合してCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物分散液を調製し、この分散液をスピンコート法により上記

透明誘電体層の表面全体に成膜し乾燥する。上記バインダとしては、アルカリ土類金属や希土類金属のアルコキシド、有機酸化合物、アセチルアセネート(例えば、カルシウムアルコキシド、有機酸カルシウム、カルシウムアセチルアセトネート、トリフルオロ酢酸カルシウム、カルシウムトリフルオロアセチルアセトネート、カルシウムへキサフルオロアセチルアセトネート)や、エチルシリケート等が用いられ、、溶媒としては、アルコール、セロソルブ等がもちいられる。又上記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末、バインダ及び溶媒の混合割合は1~40重量%、0.1~10重量%及び55~98.9重量%に設定されることが好ましい。更に上記前面ガラス基板を大気中で40~100℃に5~60分間保持して乾燥した後に、大気中で500~600℃に10~60分間保持して焼成する。

このように製造されたPDP用保護膜では、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34aとなるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面がフッ化物層により被覆されるため、PDP10の製造過程においてCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34aが大気中に長時間曝されても、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34a中のCaO

、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末がPDP10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質することは殆どないので、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34aの耐環境性を向上できる。

またCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜34a中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と

希土類酸化物との複合酸化物粉末がPDP10の機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質しないため、後工程で上記炭酸塩を除去する脱ガス処理工程時間を短縮又は脱ガス処理工程を省くことができ、PDP10の製造コストを低減できる。

更に上記CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、 又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面を被覆するフッ化物層はきわめて薄いため、このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の機械的特性はフッ化物層のないCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末と略同一である。

なお、上記第1及び第2の実施の形態では、FPDとしてPDPを挙げたが、 前面ガラス基板の表面に保護膜としてCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複 合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化 物膜を形成するものであればPALC等でもよい。

[0033]

【実施例】

次に、本発明の実施例を比較例と共に具体的に詳しく説明する。

[実施例A-1]

先ず図1に示すように、厚さ3mmの前面ガラス基板13の表面にAgの表示電極16(膜厚5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスからなる透明誘電体層17(膜厚20μm)をスクリーン印刷法により形成した。 次いでこのガラス基板13を大気中で150℃に30分間保持して乾燥した後に、大気中で550℃に30分間保持して焼成した。

次に純度99.8%のCaO焼結体ペレットを電子ビーム蒸着法により上記ガラス基板13の透明誘電体層17の表面を覆うように蒸着してCaO膜14aを形成した。このCaO膜14の成膜条件は、加速電圧が10kV、蒸着圧力が1 $×10^{-2}$ Pa、蒸着距離が200mmであった。更にこのガラス基板13を表1に示す条件でCaOの表面を改質し、CaO膜14aの表面にフッ化物層14bを形成したこのガラス基板13を実施例A-1とした。

[0034]

[実施例A-2~A-13]

実施例A-1と同様にガラス基板の表面にCaO膜を電子ビーム蒸着法により 形成した後に、このガラス基板を表1に示す夫々の条件でCaO膜の表面を改質 し、CaO膜の表面にフッ化物層を形成した。これらガラス基板を夫々実施例A -2~A-13とした。

[0035]

[実施例A-14]

先ず実施例A-1と同様に電極付ガラス基板を作製した後、純度99.99% (4N)の5インチサイズのCaOターゲットを用いてスパッタリング法によりガラス基板に透明誘電体層表面を覆うようにCaO膜を形成する。このCaO膜の成膜条件は、高周波出力が1kW、スパッタ圧力が1.0Pa、アルゴンガスに対する酸素濃度が20%、基板温度が100℃であった。

次に上記実施例A-1と同様にガラス基板を表2に示す条件で、CaO膜の表面を改質し、CaO膜の表面にフッ化物層を形成した。このガラス基板を実施例A-14とした。

[0036]

[実施例A-15~A-18]

実施例A-14と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスパッタリング法により形成した後に、このガラス基板を、表2に示す夫々の条件で、CaO膜の表面を改質し、CaO膜の表面にフッ化物層を形成した。これらガラス基板を夫々実施例A-15~A-18とした。

[0037]

[実施例A-19]

先ず厚さ3mmの前面ガラス基板13の表面にAgの表示電極16(膜厚5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスからなる透明誘電体層(膜厚20μm)をスクリーン印刷法により形成した。次いでCaO成分を含むバインダとして、2-エチルヘキサン酸カルシウムを79重量%と、CaO成分を含まないバインダとしてエチルセルロースを2重量%と、溶媒としてαーテルピオ

ールを19重量%を混合してCaOペーストを調製し、このCaOペーストを上 記ガラス基板上にスクリーン印刷法により塗布してCaO膜を形成した。

次いで上記ガラス基板を大気中で150℃に30分間保持して乾燥した後に、 大気中で550℃に30分間保持して焼成した。更にこのガラス基板を表2に示す条件にてCaO膜の表面を改質し、CaO膜の表面にフッ化物層を形成した。 このガラス基板を実施例A-19とした。

[0038]

[実施例A-20~A-23]

実施例A-19と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスクリーン印刷法により形成し乾燥・焼成した後に、このガラス基板を夫々表2に示した条件で、CaO膜の表面を改質し、CaO膜の表面にフッ化物層を夫々形成した。これらガラス基板を実施例A-20~A-23とした。

[0039]

[実施例A-24]

先ず厚さ3mmのガラス基板の表面にAgの表示電極16(膜厚5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスからなる透明誘電体層(膜圧20μm)をスクリーン印刷法により形成した。次いでCaO成分を含むバインダとしてカルシウムジメトキシドを1.25重量%と溶媒としてメチルセロソルブを98.75重量%とを混合して均一なCaOコーティング液を調製し、このコーティング液を上記ガラス基板上にスピンコート法により塗布してCaO膜を成膜した。

次に上記ガラス基板を大気中で60℃に30分間保持して乾燥した後に、大気中で580℃に10分間保持して焼成した。更にこのガラス基板を表2に示した条件にて、CaO膜の表面を改質し、CaO膜の表面にフッ化物層を形成した。このガラス基板を実施例A-24とした。

[0040]

[実施例A-25~A-28]

実施例A-24と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスピンコート法により 形成し乾燥・焼成した後に、このガラス基板を表2に示す条件下で、夫々CaO 膜の表面を改質し、このガラス基板の表面にフッ化物層を夫々形成した。 これらガラス基板を実施例A-25~A-28とした。

[0041]

[実施例A-29]

水中合成法により作製した平均粒径が500ÅのCaO粉末5gを、表3に示す条件下で処理し、CaO粉末の表面を改質した。即ちCaO粉末の表面をフッ化物層により被覆した。このCaO粉末実施例29のCaO粉末とした。

一方、図3に示すように、厚さ3mmの前面ガラス基板13の表面にAgの表示電極16(厚さ5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスからなる透明誘電体層17(膜厚20μm)をスクリーン印刷法により形成した。次いで上記表面がフッ化物層により被覆されたCaO粉末を5重量%と、バインダとして2-エチルヘキサン酸カルシウムを75重量%及びエチルセルロースを2重量%と、溶媒としてαーテルピネオールを18重量%を混合してCaOペーストを調製し、このCaOペーストを上記ガラス基板13上にスクリーン印刷法により塗布してCaO膜34aを形成した。更に上記ガラス基板13を大気中で150℃に30分間保持して乾燥した後に、大気中で580℃に10分間保持して焼成した。このガラス基板を実施例A-29とした。

[0042]

[実施例A-30~A-41]

実施例A-29と同一のCaO粉末を、表3に示す夫々の条件下で処理し、CaO粉末の表面にフッ化物層を夫々形成した。これらCaO粉末を用いて、ガラス基板上に実施例A-29と同様にCaO膜を形成した。上記表面にフッ化物層が形成されたCaO粉末及び上記ガラス基板を夫々実施例A-30~A-41とした。

[0043]

[実施例A-42]

実施例A-29と同一の条件でCaO粉末の表面にフッ化物層を形成した。このCaO粉末を実施例A-42のCaO粉末とした。

一方、実施例A-29と同様にして前面ガラス基板の表面に表示電極及び透明

[0044]

[実施例A-43~A-50]

実施例A-29と同一のCaO粉末を、表4に夫々示した条件下で処理して、 夫々CaO粉末の表面にフッ化物層を形成し、これらCaO粉末を用いて、ガラス基板上に実施例A-29と同様にCaO膜を形成した。上記表面にフッ化物層が形成されたCaO粉末及びガラス基板を夫々実施例A-43~A-50とした

[0045]

[実施例A-51]

バインダとしてトリフルオロ酢酸カルシウムを用い、焼成温度を500℃としたことを除いて、実施例A-42と同様にしてガラス基板上にCaO膜を形成した。この表面にフッ化物層が形成されたCaO粉末及び上記ガラス基板を実施例A-51とした。

[0046]

[実施例A-52]

バインダとしてカルシウムトリフルオロアセチルアセトネートを用いたことを除いて、実施例A-42と同様にしてガラス基板上にCaO膜を形成した。この表面にフッ化物層が形成されたCaO粉末及び上記ガラス基板を実施例A-52とした。

[0047]

[実施例A-53]

バインダとしてカルシウムヘキサフルオロアセチルアセトネートを用いたこと

を除いて、実施例A-42と同様にしてガラス基板上にCaO膜を形成した。この表面にフッ化物層が形成されたCaO粉末及び上記ガラス基板を実施例A-53とした。

[0048]

[比較例A-1]

実施例A-1と同様にガラス基板の表面にCaO膜を電子ビーム蒸着法により 形成したが、このCaO膜の表面は改質しなかった。このガラス基板を比較例A-1とした。

[0049]

[比較例A-2]

実施例A-14と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスパッタリング法により形成したが、このCaO膜の表面は改質しなかった。このガラス基板を比較例A-2とした。

[0050]

[比較例A-3]

実施例A-19と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスクリーン印刷法により形成し乾燥・焼成したが、このCaO膜の表面は改質しなかった。このガラス基板を比較例A-3とした。

[0051]

[比較例A-4]

実施例A-24と同様にガラス基板の表面にCaO膜をスピンコート法により 形成し乾燥・焼成したが、このCaO膜の表面は改質しなかった。このガラス基 板を比較例A-4とした。

[0052]

「比較例A-5]

表面を改質していないCaO粉末を用いて、ガラス基板の表面にし実施例A-19と同様にスクリーン印刷法によりCaO膜を形成した。上記CaO及び上記ガラス基板を比較例A-5とした。

[0053]

[比較例A-6]

表面を改質していないCaO粉末を用いて、ガラス基板の表面にし実施例E-24と同様にスピンコート法によりCaO膜を形成した。上記CaO及び上記ガラス基板を比較例A-6とした。

[0054]

[比較試験A-1及び評価]

実施例A-1~A-28及び比較例A-1~A-4のガラス基板上のCaO膜表面に形成されたフッ化物層の厚さをX線光電子分光法により深さ方向の元素分析を行って測定した。

またCaO膜の耐環境性は、CaOが炭酸塩($CaCO_3$)に変化する困難性で評価した。具体的には、炭酸塩層は、温度40℃で、湿度が90%の大気中(CO_2 濃度:約300 p p m)に2週間放置した後に、X線光電子分光法により CaO膜の深さ方向の元素分析を行い、炭酸カルシウム($CaCO_3$)に由来するカーボンの確認される深さで評価した。この深さが浅い、即ち炭酸塩層の厚さが薄いほど、保護膜が耐環境性に優れていることになる。

更にCaO膜の放電開始電圧(Vf)は、実施例 $A-1\sim A-28$ 及び比較例 $A-1\sim A-4$ のガラス基板をチャンバ内に設置し、このチャンバ内を排気後、400TorroHe-2%Xe混合ガスで満たし、10kHzの電圧を印加してそくていした。これらの測定結果を表1及び表2に示した。

[0055]

【表1】

		CaO	CaO膜表面の改質条件	質条件	-			耐環境性	
			ガス	ガスの種類及び分圧	J.分压		レッ化物		放電開始
	温度	時間		(Torr)			層の厚さ	収験塩の	電田
種別	(၃)	(₹)			ļ		(m u)	は	\ \
								(m u)	(>)
			ガス	分圧	ガス	少田			
実施例A-1	2 5	1 0	F	152	ı	1	3.0	-	165
実施例A-2	2.5	1 0	F	7.2	1	1	1 8		162
実施例A-3	2 5	1	\mathbf{F}_2	3 8	1	1	1.5	1	160
実施例A-4	2.5	1 0	\mathbb{F}_2	38		ı	1.2	2	162
実施例A-5	2.5	0 9	F	3.8	1	1	26	Ī	158
実施例A-6	25	1 0	F	7.6	ı	1	ည	1 0	172
実施例 A - 7	25	1 0	F	9 . 2	Z	752	1 0	2	170
実施例A-8	100	1 0	F2	9 . 2	١	-	2 5	2	163
実施例A-9	2.5		HF	38	1		1 0	8	174
実施例A-10	2.5	1 0	HF	9 . 7	Z.	752	က	1 0	172
実施例A-11	2.5	1 0	BF_{s}	9 .7	1		4	1 2	170
実施例A-12	2 5	1 0	SbF	9 . 2	1		∞	5	166
実施例A-13	2 5	1 0	SF4	9 . 2	1	ı	œ	9	167
比較例A-1	1	1	1	1	i	,	未処理	2.0	180

[0056]

【表2】

		CaO膜	CaO膜表面の改質条件	条件				耐環境性	
種別	温度(元)	盤盤	Ħ.	ガスの種類及び分圧 (Torr)	7分压		フッ化物層 の厚 か (nm)	炭酸塩の	放電開始 電圧 V
	<u>}</u>	3)	でき	<u> </u>
			ガス	分压	ガス	分圧		(Hu)	<u>;</u>
実施例A-14	2 5	10	F2	152	l	1	1.5		160
実施例A-15	25	1	F2	3 8	1	1	9	3	162
	2 5	0 9	F2	38	_		1.7	1	158
実施例A-17	100	10	F	7.6			13	1	160
	2.5	10	HF	7.6	N_2	752	4	က	163
実施例A-19	2 5	10	F	152	_	ı	43	2	185
実施例A-20	2 5	1	구 2	38	1		1 9	3	
実施例A-21	2.5	0 9	다. 21	38			3.7	3	180
実施例A-22	100	1 0	F	7.6			33	4	
実施例A-23	2 5	1 0	HF	7.6	Z	752	10	∞	
実施例A-24	2 5	1 0	F ₂	152	I		3.7	က	
実施例A-25	2 5	-	. ~	38	1	ı	2 0	3	182
実施例A-26	2 5	0 9	F2	3.8	1		4 0	2	
実施例A-27	100	10	전	7.6	l	1	3 5	2	1 7 9
実施例A-28	2.5	10	ΗF	7.6	Z Z	752	8	10	191
比較例A-2	1	1	1	ı	1	J	未处理	2.0	200
比較例A-3		1	1	ļ	1	1	未処理	2.5	205
比較例A-4	1	-	-	I	-	ı	未処理	23	206

[表2]

[0057]

表1および表2から明らかな様に、比較例 $A-1\sim A-4$ では、炭酸塩($CaCO_3$)が20nm及び25nmとかなり厚くCaO膜表面に形成されたのに対し、実施例 $A-1\sim A-2$ 8では、 $1\sim 12nm$ と薄くなった。またCaO膜の表面に形成されたフッ化物の厚さが厚いほど炭酸塩の厚さが薄くなった。

また、放電開始電圧は、比較例1では、180Vであったのに対して、比較例1に対応する実施例 $1\sim13$ では、 $158\sim174$ Vと若干低くなり、比較例 $2\sim4$ では、 $200\sim206$ Vであったのに対し、比較例 $2\sim4$ に対応する実施例 $14\sim28$ では、 $158\sim191$ Vと低くなった。これにより二次電子放出能が大きくなり、PDPの性能が向上したことが判った。

[0058]

[比較試験A-2及び評価]

実施例A-29~A-53、比較例A-5及びA-6のCaO粉末の表面に形成されたフッ化物層の厚さを測定することは、CaO粉末が微細であるため困難であった。そこで参考として同様の条件で処理したCaOスパッタ膜表面のフッ化物層の厚さを、X線光電子分光法により深さ方向の元素分析を行って測定した

また、CaO粉末の耐環境性は、上記比較試験A-1と同様に $CaOの炭酸塩(CaCO_3)$ に変化する困難性で評価した。具体的には、CaO粉末表面の炭酸塩層は、温度が40°Cで、湿度が90%の大気中(CO_2 濃度:約300ppm)に2週間放置した後、赤外分光法(FT-IR)の拡散反射法により炭酸塩に由来する1450cm-1付近のピークの吸光度を相対値(a、u、:aubitary unit)で表して評価した。上記吸光度の相対値が小さい、即ち炭酸塩層の厚さが薄いほど、CaO粉末が耐環境性に優れていることになる。更に、CaO膜の放電開始電圧(Vf)は、上記比較試験A-1と同様にして測定した。これらの測定結果を表 3 及び表 4 に示した。

[0059]

【表3】

		CaO	CaO粉末表面の改質条件	改質条件				耐環境体	
			H	ガスの種類及び分圧	び分圧		レッ化物		放電開始
	温度	聖盐	•	(Torr	_		層の厚さ		田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
個 別	(၃)	(₹)					(m u)	炭酸塩	V f
		-						(a. u.)	(>)
			ガス	分压	ガス	分圧			
実施例A-29	25	10	F	152		I	1 5	6	183
実施例A-30	2 5	1.0	F2	7.2	j	1	11	2 1	181
実施例A-31	2 5	1	\mathbf{F}_2	38	1		9	20	190
実施例A-32	2 5	1.0	F 2	38	ı	1	1.5	1.2	183
実施例A-33	2 5	0 9	F2	38			1 7	8	180
実施例A-34	2 5	1 0	F	9 '2			1 0	2.5	185
実施例A-35	25	1 0	\mathbb{F}_2	9 ' 2	N_2	752	6	2.4	196
実施例A-36	100	10	F_2	7.6	ı		13	1.5	
実施例A-37	2 5	1	HF	88	1		4	4 0	195
実施例A-38	2 5	1.0	HF	7.6	N_2	752	4	5 2	196
実施例A-39	2 5	1.0	BF_{3}	7.6	-		8	3.3	188
実施例A-40	2.5	1 0	SbF_5	7.6	l		9	4 0	190
実施例A-41	2 5	1.0	SF_4	7.6	i	i	သ	3 8	191
比較例A-5	ı	-	1	-	1		未処理	9.2	206

[0060]

【表4】

				-			т—	1					7.—	1	_		_	
	放電開始	電圧	J V	(>)		180	185	186	180	176	188	180	189	192	176	179	183	199
耐環境性			灰敷塩	(a. u.)		6	2 1	2 0	1 2	x	2.4	1.5	4 0	5 2	6	6	6	9.2
	レッ化を	層の厚さ	(m u)			15	1 1	9	1.5	1.7	6	1 3	4	4	1.5	1.5	1.5	未処理
					分圧	1	1	1	l	1	752		1	752	1			1
	なび分圧	<u>.</u>			ガス	1	1	1	j	1	Z			Z				1
改質条件	ガスの種類及び分圧	(Torr)			分圧	152	7.2	38	38	3 8	7.6	7.6	3 8	7.6	152	152.	152	
CaO粉末表面の改質条件	Ĭ				ガス	F 2	بنا 2	F	F	F	T 2	F	ЯH	HF	F2	2 4	F	•
CaO		時間	(₹)			1 0	1 0	1	1 0	0 9	0 1	1.0	1	1 0	1.0	1 0	10.	ı
		間 を	(၃)			2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5	100	2.5	2.5	2 5	2.5	2 5	1
			1 2 1			実施例A-42	実施例A-43	実施例A-44	実施例A-45	実施例A-46	実施例A-47	実施例A-48	実施例A-49	実施例A-50	実施例A-51	実施例A-52	実施例A-53	比較例A-6
		.	型			実施	実施(実施	実施(実施(実施	実施	実施(実施(実施(実施(実施(兄 数

[0061]

表3及び表4から明らかな様に、炭酸塩が比較例A-5及びA-6では、92とかなり多くCaO粉末表面に形成されたのに対し、実施例A-29~A-53では、8~52とかなり少なくなった。又CaO粉末(CaOスパッタ膜)の表面の形成されたフッ化物層の厚さが厚いほど炭酸塩が少なくなった。

又放電開始電圧は、比較例5及び6では、206及び199Vであったのに対し、実施例A-29~A-53では、176~196Vと低くなった。これにより二次電子放出能が大きくなり、PDPの性能が向上したことが判った。

[0062]

「実施例B-1~B-27]

先ず図1に示すように、厚さ3mmの前面ガラス基板13の表面にAgの表示電極16(膜厚5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスからなる透明誘電体層17(膜厚20μm)をスクリーン印刷法により形成した。次いでこのガラス基板13を大気中で150℃に30分間保持して乾燥した後に、大気中で550℃に30分間保持して焼成した。

[0063]

実施例A-1と同様装作で、ガラス基板の表面に表 5に示す各種蒸着材を用いて蒸着膜を電子ビーム蒸着法により形成した後に、このガラス基板を表 5に示す夫々の条件で蒸着膜の表面を改質し、蒸着膜の表面にフッ化物層を形成した。これらガラス基板を夫々実施例 $B-1\sim B-2$ 7とした。尚、実施例B-24~B-27は、 $MgOにLaB_6$ 、 La_2O_3 、 Sc_2O_3 、 Y_2O_3 を夫々2mo1%添加した蒸着材を用いて成膜し、フッ素改質を行った。

[0064]

[実施例B-28~B-50]

水中合成法により作製した表6に示した平均粒径が、約500Åの酸化物粉末5gを、表6に示す条件下でフッ素化処理し、酸化物粉末の表面を改質した。即ち酸化物粉末の表面をフッ化物層により被覆した。この酸化物粉末を実施例B-28~B-50の酸化物粉末とした。

一方、図3に示すように、厚さ3mmの前面ガラス基板13の表面にAgの表示電極16(厚さ5μm)をスクリーン印刷法により形成した後に、ガラスから

なる透明誘電体層17(膜厚20μm)をスクリーン印刷法により形成した。次に、上記表面がフッ化物層により被覆された酸化物粉末を5重量%と、バインダとして焼成後、表6に示した酸化物となる有機酸化合物1.25重量%と、溶媒としてエチルセロソルブを93.75重量%を混合して分散液を調製し、この分散液を上記ガラス基板13にスピンコート法により塗布してスピンコート膜を成膜した。更に上記ガラス基板を大気中で60℃に30分間保持して乾燥した後に、大気中で580℃に10分間保持して焼成した。このガラス基板を実施例B-28~B-50のガラス基板とした。

[0065]

【表5】

(表5)							14 27 1817 元	
		!	各種蒸脅膜の表面改質条件	面改質条件		が回題をシャク	时探观性	放電開始電圧
No.	林林	温度 [℃]	時間 [分]	ガス	分压 [Torl]	[ww]	炭酸塩厚さ [num]	vf [v]
台 特厘 R.1	Q.S					16	1	160
4 発を よっ	Si Ca		٠			15	1	165
来居所 D.2	Orsea					12	2	155
おいるない。	Oly SrlO					10	2	156
金田町口の	(Sr. Bay)	=:				16	1	160
米層がから	C(21.15)					œ	2	192
米島区 10-0	50203	-				9	1	188
4 品质 10.2	DV203		•			5	2	182
米温をある。	2076					10	2	190
水晶でいる	1 203					7	4	176
水局V D-10	Vh2O3					7	3	178
大师 四十二	MoGdOOd			,		7	3	182
大品型 B.13	MoY204					8	3	176
化品页 B.14	Mol 3004	7	_	HF	38	9	2	172
女// Brit P.15	CaGd2O4	ì				5	1	185
来落屋 P-16	CaY204	-				7	1	181
来福尼 F.17	Cal a204	-				6	2	180
所 名 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	SrG4204	-				10	4	171
中海 B-19	SrY204	T-				10	4	168
实施例 B-20	SrLa204	·				12	3	174
争核座 B-21	BaG4204		_			15	en	177
中極風 B-22	BaY204	1	-			18	-1	182
会格堡 B-23	Bal a204	-				16	1	180
供搭包 B-24	MgO:LaB6	-3	_			10	2	162
★施例 B-25	MgO:La203	-				∞	4	158
实施例 B-26	MgO:Sc203	= -	·	-		12	~	157
实施例 B-27	Mg0:Y203					12	2	158

[0066]

【表 6】

[表6]								the state of the s	
	材料		•	各種粉末の表面改質条件	1改質条件	*	フッ化物層厚	即果果住	放電開始電圧
Š	恭未	N. 47.9" -	温度 [℃]	時間 [分]	ガス	分压 [Torn]	r [nm] ≥	炭酸塩 [a.u.]	Vf [V]
母落座 B-28	QuS	SrO					9	18	183
分類 2000年200日200日200日200日200日200日200日200日200	BaO	BaO					7	16	198
分据的 B-30	(Ca-Sr)0	(Ca · Sr)O					8	25	180
政権 Ø B-31	(Mg·Sr)0	(Mg·Sr)O			•		5	17	185
实施例 B-32	(Sr·Ba)O	(Sr·Ba)O					9	18	184
虫梅网 B-33	Y203	Y203					4	16	216
と 日本	Cd203	G4203					\$	20	201
种据室 B-35	Dy203	Dy203					9	20	206
母核图 P-36	Dy203	Dy203					8	31	210
中插图 B-37	Ce02	Ce02					7	32	221
新春夏 5.38	1,4203	1,8203					8	25	509
任福屋 P-30	MeGd204	MgGd204	25	10	HF / N2	8 / 752	4	20	500
大記と、リング 世籍値 B-40	MeY204	MeY204					3	18	196
金石を変える	Mol 3204	Mel a204					4	25	198
州福度 B 42	CaG4204	CaGd204					5	22	195
数据图 B-43	Ca Y204	Ca Y204					9	16	193
安福图 84	Cal. a204	Cal.a204	•				8	14	190
研核座 B-45	SrGd204	SrG4204					œ	26	186
始格座 B-46	SrY204	SrY204					6	20	189
砂落座 B-47	SrLa204	SrLa204					10	21	194
研拓室 B-48	BaG4204	BaGd204				 -	11	23	197
研復度 B-49	BaY204	BaY204					7	27	203
₩ 接座 B-50		BaLa204	·				11	19	200
14000	4								

[0067]

[比較例B-1~B-27]

実施例 $B-1\sim B-2$ 7 と同様にガラス基板に、夫々蒸着膜を電子ビーム蒸着 法により形成したが、この膜の表面は改質しなかった。このガラス基板を比較例 $B-1\sim B-2$ 7 とし、表 7 に示した。

[0068]

[比較例B-28~B-50]

表面を改質していない酸化物粉末を用いて、ガラス基板の表面に実施例B-2 8~B-50と同様にスピンコート法により酸化物膜を形成した。上記粉末及び 上記ガラス基板を比較例B-28~B-50とし、表8に示した。

[0069]

【表7】

No. 材料 比較例 B-1 SrO 比較例 B-2 BaO 比較例 B-4 (Ca·Sr)O 比較例 B-5 (Sr·Ba)O 比較例 B-6 Y2O3 比較例 B-7 Gd2O3 比較例 B-7 Gd2O3 比較例 B-7 Gd2O3 比表の3	温度(で)	各種 森着限の牧回収 東平田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	三文文学		レッ化物層呼か	炭酸塩厚さ	及建国海通讯 Vf [V]
	頭	[代] 開報		_		し、大角をとし	[A] JA
	111		ガス	分压 [Torn]	[ww]	[mm]	
						22	185
						28	186
						25	179
	Ī					22	176
						25	191
	_ 			_		18	213
	<u> </u>	_			_	50	206
_	1		_			25	200
KKW Do	_				_	16	198
比較例 B-9 CeO2	_ _	_	_	_	_	19	190
比較网 B-10 La203				_		26	208
比較例 B-11 Yb203	_ _	_				16	212
	4		_	_	_	18	190
\dashv	_	_	_	_		26	185
_	_	_				14	187
_	4		_			16	189
_	_		_			20	192
比較例 B-17 CaLa204	4				_	22	192
	_		_	_	_	27	185
		_	_	_	_	18	195
比較例 B-20 SrLa204	4				_	16	202
_	A					14	201
_	4	-				24	206
比較例 B-23 Bala204	4	_				18	188
-	Be		_		_	14	180
	203		_		_	16	182
比較例 B-26 MgO:Sc203	203					16	186

[0070]

【表8】

[3 8]								11 to 12 to	
	林	ıð.		各種粉末の表面改質条件	1改質条件		フッ化物層厚	前架現住	放電開始電圧
ý Ž	松木	N. 479' -	温度 [C]	時間 [分]	ガス	分压 [Torr]	i [nm] ≥	炭酸塩 [a.u.]	\[\(\) \]
计数图 B.28	Q.S	SrO						101	201
比較如 B 20	Ois C	PaO						103	213
HEAD BY	Ors. sch	(Ca-Sr)O						25	196
Letter D.S.	0(20.5%)	(Ma. Sr)O			_			06	190
大概的 D-31	Ce. Boy	(Sr. Bay)			_			106	198
工数数 D-32	S(BC 15)	V203					_	100	232
LEAN D-33	1203	1203 GP03			_		_	115	216
HEXT DO	C02503	DV203		_				121	218
אל שו שיאירו	Dy203	2000				_	_	130	230
ארא מיי	2026	20.6		_	_		_	140	232
元較例 B-37	700	CEUZ	_		_			121	240
比較例 B-38	La203	La203	_		_	_		120	916
比較例 B-39	MgGd204	MgGd204		_	_	_	_	00.	200
比較例 B-40	MgY204	MgY204			_	_	_	607	2000
北較应 B-41	MgLa204	Mg1a204		_	_		_	8	252
九数图 B-42	CaGd2O4	CaGd204		_	-			S	217
比較例 B-43	CaY204	CaY204		_	_	_	_	107	710
开款室 B4	Cal.a204	CaLa204				_	_	7117	3
平数室 B45	SrGd204	SrGd204	_				_	g	190
7 ESS 19 46	╁-	SrY204		_	_		_	88	196
中特色 14.7	-	Sr1.a204		_			_	80	200
7年至 148	4-	BaGd204	_	_				92	212
工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	+	BaY204	_	_	_	_	_	96	210
元数を立て	+	Pol 1204	7				_	108	211
C-0 (4XX)	4	TOWN TOWN							

[0071]

[比較試験B-1及び評価]

実施例B-1~B-27及び比較例B-1~B-27のガラス基板上の酸化物 の蒸着膜表面に形成されたフッ化物層の厚さをX線光電子分光法により深さ方向 の元素分析を行って測定した。

また膜の耐環境性は、酸化物膜が炭酸塩に変化する困難性で評価した。具体的 には、炭酸塩層は、温度40℃で、湿度が90%の大気中(COっ濃度:約30 Oppm)に2週間放置した後に、X線光電子分光法により膜の深さ方向の元素 分析を行い、炭酸塩に由来するカーボンの確認される深さで評価した。この深さ が浅い、即ち炭酸塩層の厚さが薄いほど、保護膜が耐環境性に優れていることに なる。

更に膜の放電開始電圧 (Vf) は、実施例B-1~27及び比較例B-1~B -27のガラス基板をチャンバ内に設置し、このチャンバ内を排気後、400T orrのHe-2%Xe混合ガスで満たし、10kHzの電圧を印加して測定し た。これらの測定結果を表5及び表7に示した。

[0072]

[比較試験B-2及び評価]

実施例B-28~B-50、比較例B-28及びB-50の粉末の表面に形成 されたフッ化物層の厚さを測定することは、粉末が微細であるため困難であった 。そこで参考として同様の条件で処理したスパッタ膜表面のフッ化物層の厚さを 、X線光電子分光法により深さ方向の元素分析を行って測定した。

また、粉末の耐環境性は、上記比較試験B-1と同様に炭酸塩に変化する困難 性で評価した。具体的には、粉末表面の炭酸塩層は、温度が40℃で、湿度が9 0%の大気中(CO₂濃度:約300ppm)に2週間放置した後、赤外分光法 (FT-IR)の拡散反射法により炭酸塩に由来する1450cm-1付近のピ ークの吸光度を相対値(a、u、:aubitary unit)で表して評価 した。上記吸光度の相対値が小さい、即ち炭酸塩層の厚さが薄いほど、粉末が耐 環境性に優れていることになる。更に、膜の放電開始電圧(Vf)は、上記比較 試験B-1と同様にして測定した。これらの測定結果を表6及び表8に示した。

[0073]

表5~表8から明らかな様に、比較例B-1~B-27では、炭酸塩が14 n

4 3

m及び28nmとかなり厚く膜表面に形成されたのに対し、実施例B-1~B-27では、1~5nmと薄くなった。また膜の表面に形成されたフッ化物の厚さが厚いほど炭酸塩の厚さが薄くなった。

また、放電開始電圧は、比較例 $1\sim2.7$ では、 $1.7.6\sim2.1.3$ Vであったのに対して、比較例 $B-1\sim B-2.7$ に対応する実施例 $B-1\sim B-2.7$ では、 $1.5.5\sim1.9.2$ Vと若干低くなり、また比較例 $B-2.8\sim B-5.0$ では、 $1.9.0\sim2.4.0$ Vであったのに対し、比較例 $B-2.8\sim B-5.0$ に対応する実施例 $B-2.8\sim B-5.0$ では、 $1.8.0\sim2.2.1$ Vと低くなった。これにより二次電子放出能が大きくなり、PDPの性能が向上したことが判った。

[0074]

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、基板の表面にCaO、SrO、BaO、 アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化 物との複合酸化物膜を形成し、このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合 酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物 膜の表面にフッ化物層を形成したので、FPDの製造過程において保護膜が大気 中に長時間曝されても、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希 土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のC a O、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土 類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物が大気中のCO2ガスと殆ど反応しない 。この結果、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物 、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のCaO、SrO 、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と 希土類酸化物との複合酸化物がFPDの機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質 することが殆どないので、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、 希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の耐環 境性を向上できる。

また保護膜のうち基板と熱膨張係数が略同一のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物と

の複合酸化物膜が接着されるので、熱サイクルにより保護膜が基板から剥離せず 、保護膜の基板に対する密着性及び整合性が極めて良好となる。

[0075]

また基板の表面に形成されるCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化 物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜を 、フッ化物層にて被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物 、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を 用いて形成すれば、上記と同様にFPDの製造過程において保護膜が大気中に長 時間曝されても、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸 化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のCaO、S rO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化 物と希土類酸化物との複合酸化物が大気中のCO₂ガスと殆ど反応しない。この 結果、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又は アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のCaO、SrO、Ba O、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類 酸化物との複合酸化物がFPDの機能を損なうおそれのある炭酸塩に変質するこ とが殆どなく、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化 物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の耐環境性を向上 できる。またCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物 、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面を被覆する フッ化物層は極めて薄いため、このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合 酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物 粉末の機械的特性は表面にフッ化物層のないCaO、SrO、BaO、アルカリ 土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複 合酸化物粉末と略同一である。

[0076]

またフッ化物層がMOxFy(0≦x<2,0<y≦4:Mは、Ca、Sr、 Ba、アルカリ土類複合金属、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希土類金属 との複合金属)であったり、フッ化物層をガス状フッ素化剤とCaO、SrO、 BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物との反応にて得たり、ガス状フッ素化剤として、フッ素ガス、フッ化水素ガス、 BF_3 、 SbF_5 又は SF_4 等を用いたり、或いはフッ化物層の厚さを $1\sim1000$ nmの範囲内に形成したりすれば、上記効果を更に顕著に奏することができる。

[0077]

また基板の表面にCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜を形成し、このCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜をガス状フッ素化剤にて表面処理することによりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜の表面にフッ化物層を形成すれば、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類酸化物と希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物、発工アルカリ土類酸化物と希土類酸化物、発生アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物がFPDの機能にとって有害な炭酸塩に殆ど変質しないため、後工程で上記炭酸塩を除去する脱ガス処理工程時間を短縮又は脱ガス処理工程を省くことができ、FPDの製造コストを低減できる。

[0078]

またCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をガス状フッ素化剤にて表面処理することによりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末をフッ化物層にて被覆し、このフッ化物層により被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末とバインダと溶媒とを混合して調製されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物のペースト又はCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物との複

合酸化物の分散液を用いて基板の表面にCaO、SrO、BaO、アルカリ土類 複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸 化物膜を形成すれば、上記と同様にCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合 酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物 膜中のCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又は アルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末がFPDの機能にとって 有害な炭酸塩に殆ど変質しないため、後工程で上記炭酸塩を除去する脱ガス処理 工程時間を短縮又は脱ガス処理工程を省くことができ、FPDの製造コストを低 減できる。

[0079]

また圧力が1~760Torrのガス状フッ素化剤によりCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜又はCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末を表面処理したり、ガス状フッ素化剤としてフッ素ガス、フッ化水素ガス、BF3、SbF5又はSF4等を用いたりすれば、CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜又はCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物粉末の表面に二次電子放出能の高いフッ化物層を比較的容易に形成することができる。

さらに上記保護膜を用いてFPDを製造すれば、FPDの製造工数を大幅に低減できるので、安価にFPDを製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明第1実施形態の保護膜が形成された前面基板の断面図。

【図2】

上記前面基板が組み込まれたPDPの要部断面図。

【図3】

本発明第2実施形態の保護膜が形成された前面基板の断面図。

【図4】

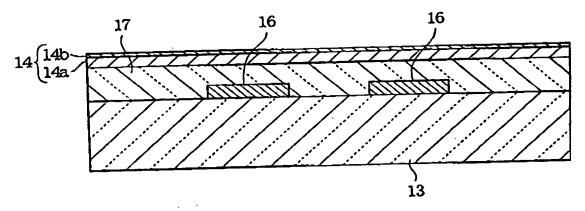
上記前面基板が組み込まれたPDPの要部断面図。

【符号の説明】

- 10 PDP (FPD)
- 11 背面ガラス基板
- 12 隔壁
- 13 前面ガラス基板(基板)
- 14,34 保護膜
- 14a CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、 又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜
- 16 表示電極
- 17 透明誘電体層
- 18 放電セル
- 19 アドレス電極
- 21 蛍光体層
- 34a CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、 又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の粉末を含有し た膜

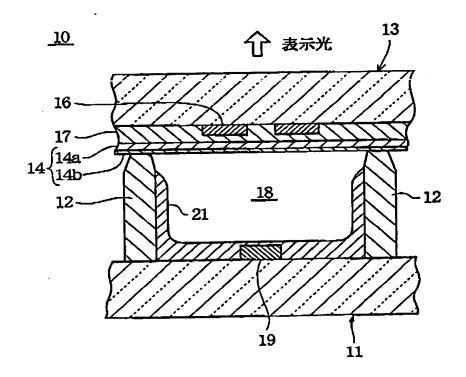
【書類名】 図面

【図1】

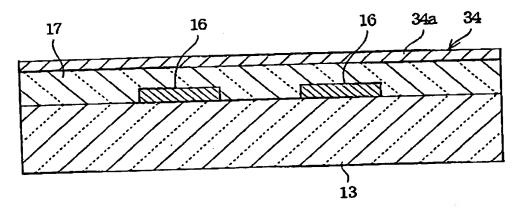


- 10 PDP (FPD)
- 13 前面ガラス基板(基板)
- 14 保護膜
- 14a CaO, SrO, BaO, アルカリ土類複合酸化物, 希土類酸化物又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化 物との複合酸化物膜
- 146 フッ化物層

【図2】

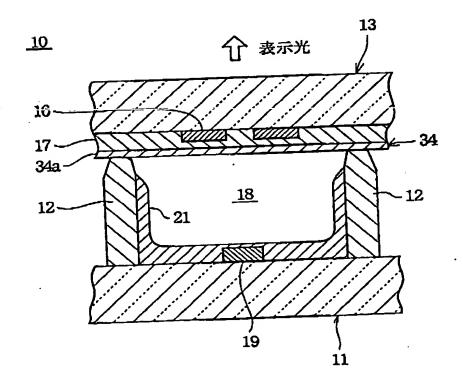


【図3】



- 10 PDP (FPD)
- 13 前面ガラス基板(基板)
- . 14 保護膜
 - 34a 表面をフッ素化した CaO, SrO, BaO, アルカリ土類複合酸化物, 希土類酸化物又はアルカリ 上類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物の粉末を 含有した膜

【図4】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】FPD用保護膜及びその製造方法並びにこれを用いたFPDを提供する

【解決手段】基板(13)の表面に形成されたCaO、SrO、BaO、アルカ リ土類複合酸化物、希土類酸化物又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複 合酸化物膜(14a)と、該CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化物 、希土類酸化物又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(14 a)の表面に形成されたフッ化物層(14b)とからなるFPD用保護膜、基板 (13) の表面に形成された該CaO、SrO、BaO、アルカリ土類複合酸化 物、希土類酸化物又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物膜(3 4 a)が、フッ化物層にて被覆されたCaO、SrO、BaO、アルカリ土類複 合酸化物、希土類酸化物又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物との複合酸化物 膜粉末を用いて形成されたFPD用保護膜、上記フッ化物層が、MOxFy(但 し、0≤x<2、0<y≤4:Mは、Ca、Sr、Ba、アルカリ土類複合金属 、希土類金属、又はアルカリ土類金属と希土類金属との複合金属)であるFPD 用保護膜、上記フッ化物層が、ガス状フッ素化剤とCaO、SrO、BaO、ア ルカリ土類複合酸化物、希土類酸化物、又はアルカリ土類酸化物と希土類酸化物 との複合酸化物との反応によって得られたFPD用保護膜、上記ガス状フッ素化 剤が、フッ素ガス、フッ化水素ガス、BF3、SbF5又はSF4のいずれかであ るFPD用保護膜と上記FPD用保護膜の製造方法並びに上記被覆粉末、ペース ト、分散液およびFPDからなる。

【選択図】 図1



出願人履歴情報

識別番号

[000006264]

1. 変更年月日

1992年 4月10日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

氏 名

三菱マテリアル株式会社